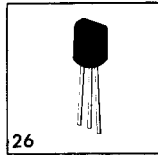


2SA701, 702

超低雑音増幅用

Epitaxial Planar Type Silicon Transistor
For Low Noise Amplifier Use



★Superior linearity of hFE at low current range.

⊖ 345A

低電流領域における h_{FE} の直線性がすぐれており 低雑音回路に最適である。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		2SA701	2SA702	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-30	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-30	-50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}		-5	V
コレクタ電流	I_C		-50	mA
コレクタ損失	P_C		200	mW
接合部温度	T_j		125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55~+125		$^\circ\text{C}$

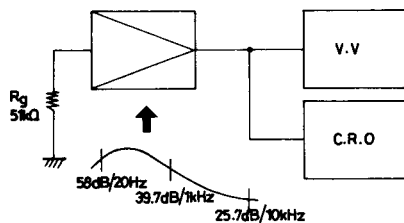
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$			min	typ	max	単位
コレクタレキ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-25\text{V}, I_E=0$	2SA701		-1	μA
		$V_{CB}=-45\text{V}, I_E=0$	2SA702		-1	μA
エミッタレキ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-4\text{V}, I_C=0$			-1	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	$I_C=-10\mu\text{A}$	2SA701	-30		V
		$I_C=-10\mu\text{A}$	2SA702	-50		V
直流電流増幅率	h_{FE}^{\ast}	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$		100 *	200	560 *
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$			80	MHz
出力雑音電圧	V_{NO}	$V_{CC}=-30\text{V}, I_C=-0.1\text{mA}$	U		0.65	mV
		$V_G=39.7\text{dB}/1\text{kHz}, R_G=51\text{k}\Omega$	α		1.00	mV

※ 2SA701, 702は 1mA h_{FE} により次のように分類している。

100	E	200	160	F	320	280	G	560
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

関連製品：シリコン NPN トランジスタ類似品は 2SC693を使用したい。

出力雑音電圧測定アンプ



外形図 [26]
(単位: mm)

